

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年9月4日(2008.9.4)

【公表番号】特表2008-511172(P2008-511172A)

【公表日】平成20年4月10日(2008.4.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-014

【出願番号】特願2007-529864(P2007-529864)

【国際特許分類】

H 01 L 21/338 (2006.01)

H 01 L 29/778 (2006.01)

H 01 L 29/812 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/80 H

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体構造であって、

第1半導体層と、

前記第1半導体層上の第2半導体層と、

前記第2半導体層上の第3半導体層と、

前記第3半導体層上の第4半導体層と、

前記第1半導体層に結合した第1導電体部分と、

前記第1半導体層上の第2導電体部分とを備える半導体構造。

【請求項2】

前記第2半導体層は、第1凹部層を備え、

前記第3半導体層は、第2凹部層を備え、

前記第4半導体層は、第3凹部層を備える請求項1に記載の半導体構造。

【請求項3】

前記第2導電体部分は、前記第1凹部層から電気的に絶縁されている請求項2に記載の半導体構造。

【請求項4】

半導体構造の製造方法であって、

第1半導体層を形成する工程と、

前記第1半導体層上に第2半導体層を形成する工程と、

前記第2半導体層上に第3半導体層を形成する工程と、

前記第3半導体層上に第4半導体層を形成する工程と、

前記第2半導体層に結合した第1導電体部分を形成する工程と、

前記第1半導体層上に第2導電体部分を形成する工程とを備える方法。

【請求項5】

開口を形成するために、前記第2半導体層をパターニングする工程であって、前記第1導電体層の一部分は、前記開口内にある、第2半導体層のパターニング工程と、

前記第2半導体層に対して前記第3半導体層に凹部形成するために、前記第3半導体層

をパターニングする工程と、

前記第3半導体層に対して前記第4半導体層に凹部形成するために、前記第4半導体層をパターニングする工程とをさらに備える請求項4に記載の方法。